FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電気的特性 (Ta=25°C)														外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルスh_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10^{-4})	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)		
1	2	3	4	5					6		7			8						9	10		11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE}, I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB}, I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 f_{ab} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

：とコンプリ： COMPLEMENTARY TO ………

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)														外形	備考
					V_{CBO}	V_{EBO}	I_C	P_C	T_j	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}			バイアス		h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}*	h_{re} h_{ro}*	h_{oe} h_{ob}*	f_{ab} f_T*	C_{ob}	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$*		
					(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(μA)	V_{CB}(V)		V_{CE}(V)	I_C(mA)	V_{CB}(V)	I_E(mA)		(Ω)	(×10⁻⁴)	(μ℧)	(Mc)	(pF)	(Ω)		
	2SC915	富士通、沖 日電	SW	Si. EP	30	5	300	300	175	0.2	20	70	1	30			t_{on}<45nS, t_{off}<42nS t_{stg}<27nS					2.5		49C	
	〃 916	〃	〃	〃	100	5.5	1.5 A	2 W	175	10	80	70	1	400			t_{on}<63nS, t_{off}<210nS t_{stg}<190nS					30		83	
★	〃 917	日立	RF	Si. P	40		50	300	175	10	40	40	10	10	10	−10					800 *	1	$C_c r_{bb'}$ 5 pS	56C	
★	〃 918	ソニー	〃	Si. DB	20		30	188	100	0.2	15	80	10	4	10	−4	h_{fe}=12dB (f=100 MHz)					0.7	$C_c r_{bb'}$ 10pS	205C	
	〃 919																								
★	〃 920	日電	RF. Conv. Mix. Osc. LN	Si. E	50	5	30	150	150	0.1	15	75	3	0.5	6	−1	NF = 2.5dB (f= 1 Mc)				250 *	1.6	$C_c r_{bb'}$ 30pS	23	
★	〃 921	〃	RF. Conv. Mix. Osc.	〃	25	2	10	100	150	0.1	12	65	3	0.5	6	−1					650 *	0.9	$C_c r_{bb'}$ 9 pS	23	
★	〃 922	〃	〃	〃	30	5	20	250	125	0.1	20	80	6	1	6	−1					650 *	1.1	$C_c r_{bb'}$ 15pS	138	
★	〃 923	〃	RF. AF	〃	40	5	100	250	125	0.05	40	500	3	0.5	6	−1					100 *	3.5	50 *	138	2SA641 とコンプリ
★	〃 924	〃	〃	Si. EP	30		50	250	125	0.1	15	100	3	0.5	6	−1	130	3800	0.6	8	250 *	1.8	$C_c r_{bb'}$ 20pS	138	
★	〃 925	〃	RF. AF. SW	〃	30	5	50	250	125	0.1	30	130	12	2	12	−2	140	2300	3.5	45	250 *	1.8	50	138	
★	〃 926	ソニー	RF. SW	Si. DB	115	3.5	100	100	120	0.2	115	50	3	1	10	−2					160 *	2.5	$C_c r_{bb'}$ 40pS	38	
★	〃 927	三洋	RF. LN	Si. TP	30	3	20	150	125	1	25	80	6	1	6	−3					500 *	0.7	$C_c r_{bb'}$ 3.0 pS	205C	
★	〃 928	〃	RF	〃	30	3	20	150	125	1	25	80	6	1	6	−3					500 *	0.7	$C_c r_{bb'}$ 3 pS	205C	
★	〃 929	〃	RF. Conv. LN	Si. EP	30	5	30	250	125	1	10	100	6	1	6	−1					300 *	Cre 1.3	$C_c r_{bb'}$ 20pS	138	
★	〃 930	〃	RF	〃	30	5	30	250	125	1	10	80	6	1	6	−1					300 *	Cre 1.3	$C_c r_{bb'}$ 20pS	138	
★	〃 931	〃	PA	Si. TMe	50		3 A	10 W (T_c=25°C)	125	1 mA	45	70	2	1 A	5	−0.5A					120 *	100	35	120	
★	〃 932	〃	〃	〃	30		3 A	10 W (T_c=25°C)	125	1 mA	25	70	2	1 A	5	−0.5A					120 *	100	35	120	
★	〃 933	〃	AF	Si. EP	50	5	300	300	125	1	45	150	5	20	6	−5					300 *	5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	138	
★	〃 934	〃	〃	〃	20	5	300	300	125	1	15	150	5	20	6	−5					300 *	5	$C_c r_{bb'}$ 120pS	138	
★	〃 935	日立	PA	Si. T	300	5	2.5 A	50 W (T_c=25°C)	150	I_{CBX} 1mA	300	14	10	300										102	
★	〃 936	〃	〃	〃	1000	5	1 A	22 W	125	I_{CBX} 1mA	1000	45	10	100										102	
★	〃 937	〃	〃	〃	1200	6	2.5 A	22 W (T_c=25°C)	125	I_{CBX} 1mA	1200	8	10	2.5A			t_f<1.2μS							102	
	〃 938	日電	RF	Si. E	60	5	200	250	125	0.1	60	80	1	50	10	−10					90 *	7.5	40 *	138	
★	〃 939	〃	PA. SW	Si. EMe	150	7	5 A	50W (T_c=25°C)	150	2mA	60	70	5	5 A	10	−200					20 *	150	20 *	102	
	〃 940	〃	〃	SiEMe	200	7	5 A	50W (T_c=25°C)	150	2mA	90	40	5	5 A	10	−200		t_f< 1 μS			20 *	150	20 *	102	
★	〃 941	東芝	RF. LN	Si. E	35	4	100	400	125	0.1	20	40~240	12	2	10	−2	NF = 2 dB (f= 1 Mc, I_E= − 1mA)				120 *	Cre 2.2	$C_c r_{bb'}$ 30pS	138	
★	〃 942	富士通	RF	Si. EP	20	3	20	300/unit	175	0.5	10				6	−2	70				700 *	1.3	80 *	122C	直結2段 2素子複合
	〃 943	日電	〃	Si. E	60	8	200	300	150	0.5	40	150	1	10	10	−10					250 *	3.4	40	49C	
	〃 944	〃	RF. AF. SW	〃	60	8	100	250	125	0.1	40	180	10	2	6	−10					250 *	2.2	$C_c r_{bb'}$ 40pS	138	